

ОТЗЫВ
о научной деятельности соискателя ученой степени
кандидата физ.-мат. наук Самосвата Дмитрия Михайловича

Дмитрий Самосват начал работу в Секторе теоретических основ микроэлектроники ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН в 2002г., будучи студентом первого курса Физико-технического факультета Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета. С самого начала работы Д.М. Самосват показал себя в качестве заинтересованного и упорного исследователя, одновременно осваивая методы теоретической физики и решая поставленную перед ним задачу о механизмах оже-рекомбинации в квантовых точках.

К настоящему времени Дмитрием Самосватом решено несколько актуальных физических проблем, связанных с безызлучательными процессами рекомбинации и спектре открытых квантовых точек, помещенных в электрическое поле. Он является соавтором 9 научных статей в российских и международных журналах, его работы представлялись на ведущих конференциях по физике полупроводников.

В 2009г. научные успехи Д.М. Самосвата были отмечены дипломом на XI Всероссийской молодежной конференции по физике полупроводников и наногетероструктур за доклад «Оже-рекомбинация в квантовых точках, туннельно связанных с квантовой ямой»

Я считаю, что диссертация Д.М. Самосвата — важный вклад в теорию безызлучательных процессов в полупроводниковых квантовых точках, а ее автор несомненно достоин присуждения ученой степени кандидата физ.-мат. наук.

Научный руководитель,
г.н.с. ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН,
проф., д.ф.-м.н.

Г.Г. Зегря

Ученый секретарь
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН,
д.ф.-м.н.

А.П. Шергин